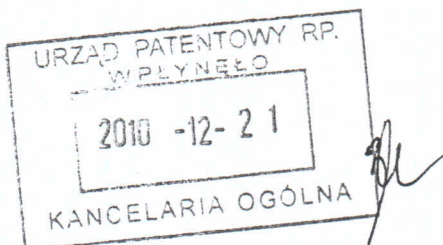


Miejsce na pieczętę zgłaszającego

Znak DN/MP/19/2010.....

ODRĘCZONO OSOBIŚCIE



Nr .....

Data zgł. ....

Int. Cl. ....

.....  
podpis członka  
Komisji Klasyfik.

.....  
podpis przewod.  
Komisji Klasyfik.

(wypełnia Urząd Patentowy)

**URZĄD PATENTOWY  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

00-950 WARSZAWA,  
Al. Niepodległości 188/192  
Skr. poczt. 203

**PODANIE**

ZGŁASZAJĄCY <sup>1)</sup> **Instytut Technologii Elektronowej**

(podać kolejno: nazwisko i imię lub nazwę oraz adres)

**02-668 Warszawa Al. Lotników 32/46**

NIP **5 2 5 0 0 0 9 1 1 1** .....

Numer ewidencyjny PESEL\* .....

Numer identyfikacyjny REGON\* **0 0 0 0 3 8 9 7 1**

PEŁNOMOCNIK <sup>2)</sup> - .....  
(nazwisko i imię oraz adres pełnomocnika)

Wnoszę (wnosimy) o udzielenie <sup>3)</sup>: ~~patentu na wynalazek\*~~ ~~prawa ochronnego na wzór użytkowy\*~~  
~~dotychczasowego do\*~~ pod tytułem: **Struktura półprzewodnikowa z reaktywną barierą antykorozyjną  
oraz sposób wytwarzania reaktywnej bariery antykorozyjnej**

(podać tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego)

Oświadczenie o korzystaniu z pierwszeństwa <sup>4)</sup>:

Data zgłoszenia (data wystawienia)	Kraj zgłoszenia (miejsce i kraj wystawy)	Numer zgłoszenia (nazwa wystawy)

TWÓRCA(Y) WYNALAZKU (~~WZORU UŻYTKOWEGO~~)

**1. Eliana Kamińska zam. 00-743 Warszawa ul. Nabelaka 13 m 6**

(nazwisko i imię oraz adres)

**2. Anna Piotrowska zam. 01-031 Warszawa ul. Narbutta 9 m 4**

**3. Michał Borysiewicz zam. 00-391 Warszawa Al. 3 Maja 2 m 71**

**4. Iwona Pasternak zam. 02-698 Warszawa ul. Niegocińska 14/125**

<sup>\*)</sup> niepotrzebne skreślić

**URZĄD PATENTOWY  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**  
**Kancelaria Ogólna**  
Al. Niepodległości 188/192  
00-950 Warszawa  
skr. poczt. 203

BA-I/P.393392/Potw.1/iber  
INSTYTUT TECHNOLOGII  
ELEKTRONOWEJ  
recz. pat. Magdalena Jung  
Al. Lotników 32/46  
02-668 Warszawa

Nasz znak: BA-I/P.393392/Potw.1/iber  
Wasz znak: DN/MP/19/2010

### **POTWIERDZENIE**

Urząd Patentowy RP stwierdza, że dnia **2010-12-21** przyjęto wnioski o udzielenie patentu na wynalazek pt.:

**Struktura półprzewodnikowa z reaktywną barierą antykorozyjną oraz sposób wytwarzania reaktywnej bariery antykorozyjnej**

Zgłoszenie oznaczono numerem **P.393392**

[WIPO ST 10/C PL393392]

Zgłaszający: **INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ, Warszawa, Polska**

Pouczenie:

1. Strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić Urząd o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 kpa).
2. W korespondencji należy powoływać się na nr P.393392.

**PODREFBRENDARZ**

*Irena Bernacka*